

# 3SK80

シリコン N チャンネルデュアルゲート MOS FET

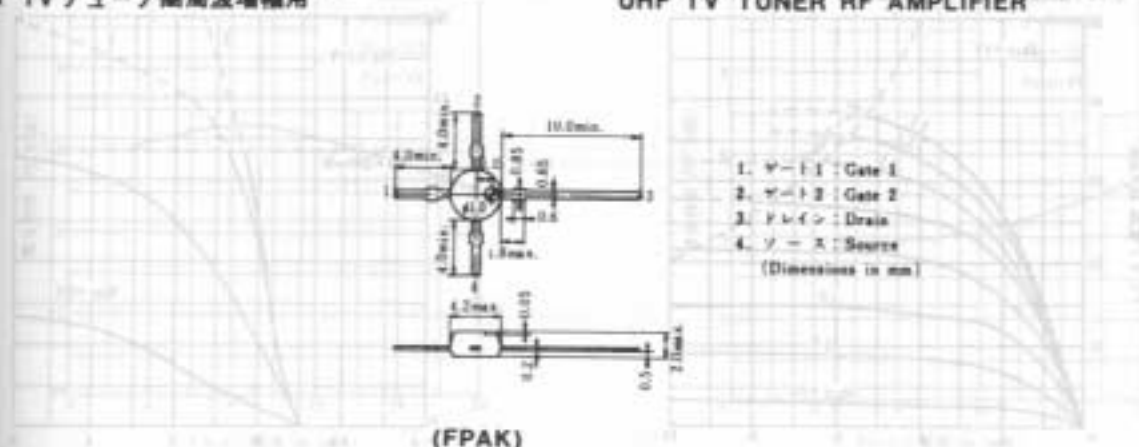
UHF 高周波増幅用

UHF TV チューナ高周波増幅用

SILICON N-CHANNEL DUAL GATE MOS FET

UHF AMPLIFIER

UHF TV TUNER RF AMPLIFIER

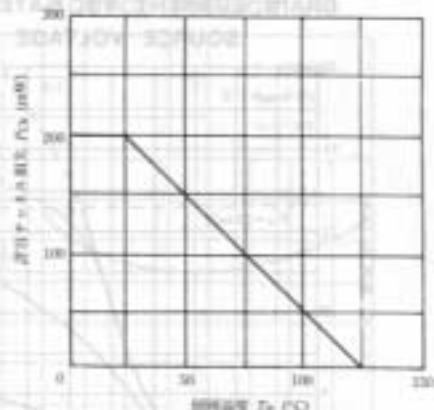


(FPAK)

## 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	3SK80	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DS}$	20	V
ゲート1・ソース電圧	$V_{G1S}$	$\pm 8$	V
ゲート2・ソース電圧	$V_{G2S}$	$\pm 8$	V
ドレイン電流	$I_D$	50	mA
許容チャネル損失	$P_{ch}$	200	mW
チャネル温度	$T_{ch}$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

## 許容チャネル損失の周囲温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



## 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{DS(BO)}$	$I_D=200\mu\text{A}, V_{G1S}=V_{G2S}=-5\text{V}$	20	—	—	V
ゲート1・ソース破壊電圧	$V_{G1S(BO)}$	$I_{G1}=\pm 10\text{mA}, V_{G2S}=V_{DS}=0$	$\pm 8$	—	—	V
ゲート2・ソース破壊電圧	$V_{G2S(BO)}$	$I_{G2}=\pm 10\text{mA}, V_{G1S}=V_{DS}=0$	$\pm 8$	—	—	V
ゲート1遮断電流	$I_{G1S}$	$V_{G1S}=\pm 5\text{V}, V_{G2S}=V_{DS}=0$	—	—	$\pm 20$	nA
ゲート2遮断電流	$I_{G2S}$	$V_{G2S}=\pm 5\text{V}, V_{G1S}=V_{DS}=0$	—	—	$\pm 20$	nA
ゲート1・ソース遮断電圧	$V_{G1S(OFF)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{G2S}=4\text{V}, I_D=100\mu\text{A}$	—	—	-3	V
ゲート2・ソース遮断電圧	$V_{G2S(OFF)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{G1S}=0, I_D=100\mu\text{A}$	—	—	-3	V
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{G1S}=0, V_{G2S}=4\text{V}$	1.0	—	20	mA
伝達アトミタンス [dB]		$V_{DS}=15\text{V}, V_{G1S}=4\text{V}, I_D=7\text{mA}, f=1\text{kHz}$	7	—	—	mS
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{G1S}=4\text{V}, I_D=7\text{mA}, f=1\text{MHz}$	—	—	5	pF
出力容量	$C_{oss}$		—	—	4	pF
伝達容量	$C_{trr}$		—	0.02	—	pF
電力利得	PG	$V_{DS}=15\text{V}, V_{G1S}=4\text{V}, I_D=7\text{mA}, f=900\text{MHz}$	10	—	—	dB
音価	NF		—	—	6	dB